

# 2SD1765

エピタキシャルプレーナ形 NPN シリコンダーリントトランジスタ  
低周波電力増幅用/Low Freq. Power Amp.  
Epitaxial Planar NPN Silicon Darlington Transistor

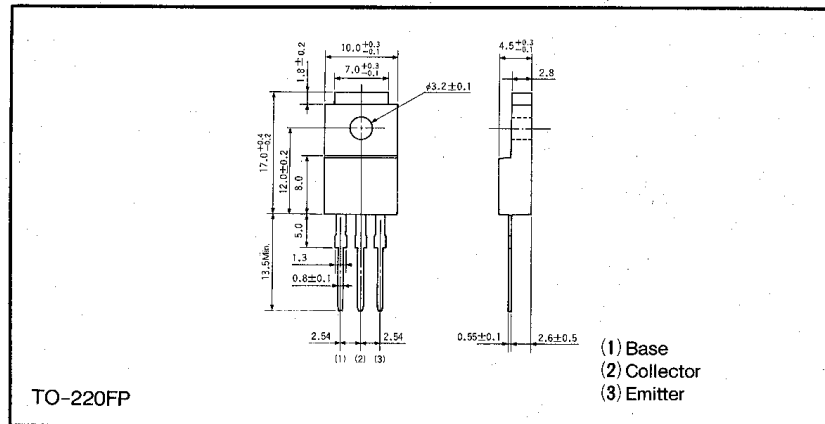
## ● 特長

- 1) ダンパダイオード内蔵。
- 2) ベース・エミッタ間に抵抗内蔵。
- 3) フィンをフルモールドで覆っているため、放熱板との絶縁が容易。

## ● Features

- 1) Damper diode is incorporation.
- 2) Built-in resistance between base and emitter.
- 3) Full-mold covered fin enables easy insulation from heat sink.

## ● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



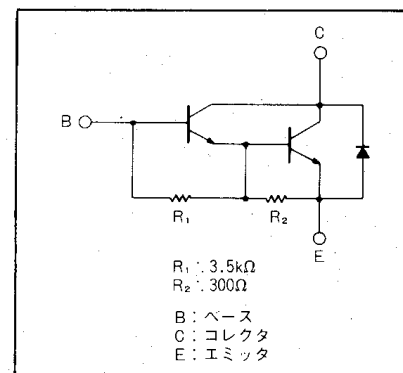
トランジスタ

2SDタイプ

## ● 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V <sub>CB0</sub>	100	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V <sub>CEO</sub>	100	V
エミッタ・ベース間電圧	V <sub>EBO</sub>	6	V
コレクタ電流	I <sub>C</sub>	2	A
		3	A(Pulse)
コレクタ損失	P <sub>C</sub>	20	W(T <sub>C</sub> =25°C)
		2	W(T <sub>a</sub> =25°C)
接合部温度	T <sub>j</sub>	150	°C
保存温度範囲	T <sub>stg</sub>	-55~150	°C

## ● 内部等価回路図



## ● 電気的特性 / Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV <sub>CEO</sub>	100	—	—	V	I <sub>C</sub> = 5mA
コレクタ・ベース降伏電圧	BV <sub>CB0</sub>	100	—	—	V	I <sub>C</sub> = 50 μA
コレクタシャ断電流	I <sub>CB0</sub>	—	—	10	μA	V <sub>CB</sub> = 100V
エミッタシャ断電流	I <sub>EBO</sub>	—	—	3	mA	V <sub>EB</sub> = 5V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V <sub>CE(sat)</sub>	—	—	1.5	V	I <sub>C</sub> /I <sub>B</sub> = 1A/1mA
直流電流増幅率	h <sub>FE</sub>	1000	—	10000	—	V <sub>CE</sub> /I <sub>C</sub> = 2V/1A
出力容量	C <sub>ob</sub>	—	25	—	pF	V <sub>CB</sub> = 10V, I <sub>E</sub> = 0A, f = 1MHz

## ● 標準品・準標準品一覧表 (◎:標準品 ○:準標準品)

Type	h <sub>FE</sub>	包装名	トレイ
		記号	Y2
		基本発注単位(個)	200
2SD1765	1K~10K		◎